

姓名: 陈致蓬

单位:中南大学自动化学院

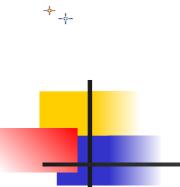
电话: 15200328617

Email: ZP.Chen@csu.edu.cn

Homepage:

https://www.scholarmate.com/psnweb/homepage

QQ: 315566683



第5章 RAM、MMU、ROM

5.1 RAM

5.2 MMU

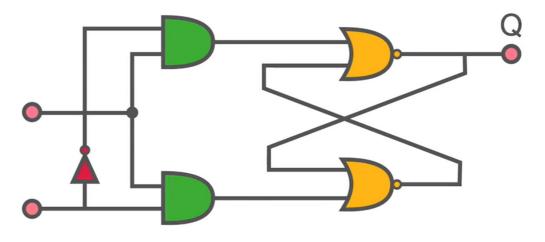
5.3 ROM



SRAM:

- 缓存采用静态随机存取存储器 (Static Random Access Memory, SRAM) 实现
- 由 RS 触发器保持数据,无需刷新
- 速度比 DRAM 快,比寄存器慢,但 电路结构更复杂,难以大规模集成, 因此用于 CPU 中的缓存

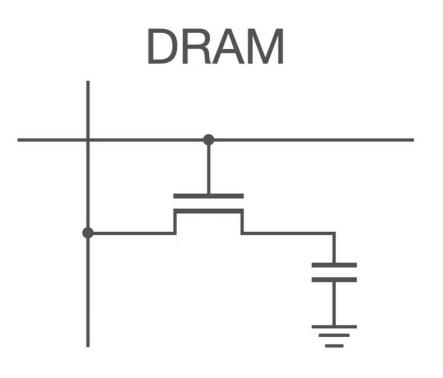
SRAM静态





DRAM:

- 采用动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory, DRAM) 实现
- 采用电容存储信息,结构简单
- 电容存在漏电流,需要动态刷新给电容充电,因此得名 DRAM
- 由于电容充电和刷新需要时间,因此其相较于 SRAM 要更慢

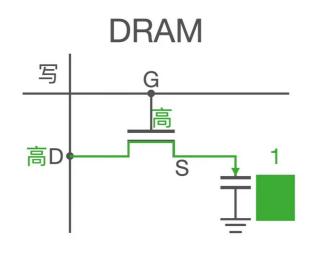


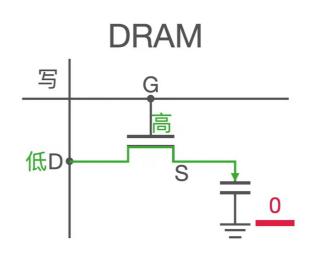


5.2.1 内存电路实现

DRAM写:

■ G 极通高电平,三极管导通, D 极通高电平,电容充电,写入 1 , 通低电平,电容放电,写入 0

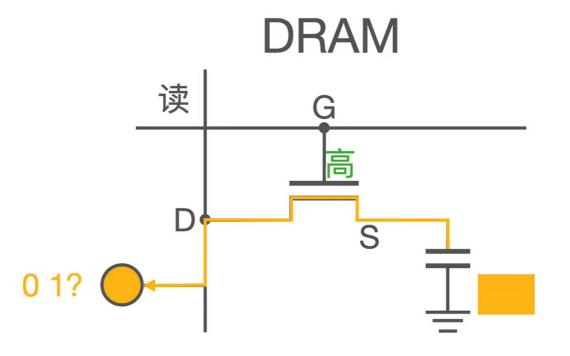






DRAM 读:

G 极通高电平,三极管导通,D 极接信号放大器读取电容中的电压信息,判断存储的值

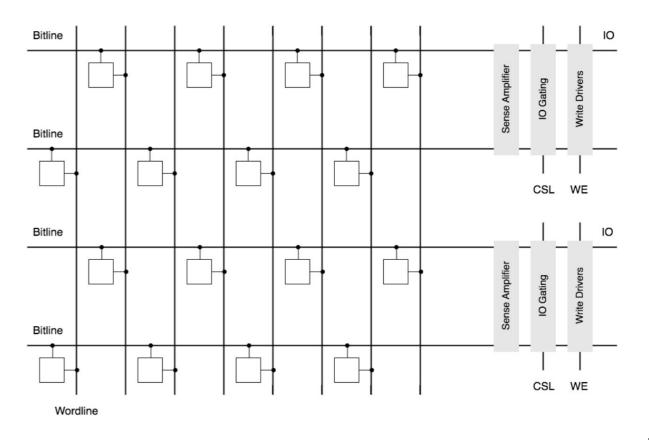




5.2.2 内存构成和寻址

内存构成:

- 由多个 Cell 以特定的方式组成一个 Memory Array,也称一个 Bank
- 空间 (bit) = m x n x w
 - 字线数 m
 - CSL或WE数n
 - 一次读写的最小 bit 数 w

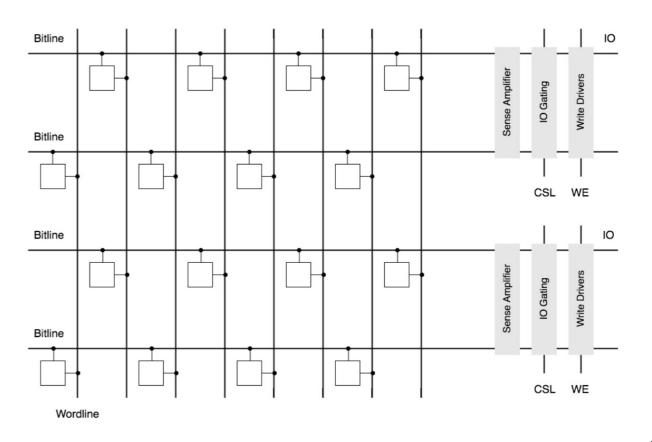




5.2.2 内存构成和寻址

内存寻址:

- 将列连成组,构成最小可寻址 单元
- 对最小寻址单元进行编址
- 使能相应的字线、 CSL 和 WE ,控制最小寻址空间的读写





5.2.3 程序读写内存的方式

程序在内存上:

■ 内存空间分段,将程序分段为连续的代码段、数据段、堆栈段

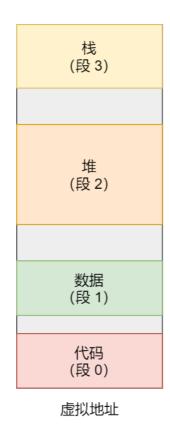
直接读写内存:

- 将程序给段直接分配到实际物理地址上,CPU 直接用物理地址访问内存
- 在多程序同时执行时,可能会出现多程序同时操作同一内存的情况,出现不安全问题
- 因此后来出现了虚拟内存

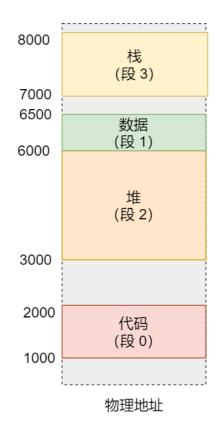


虚拟内存(早期):

- 为各个程序分配虚拟内存,各个程序在虚拟内存上进行分段
- 将各段映射到连续的物 理空间中



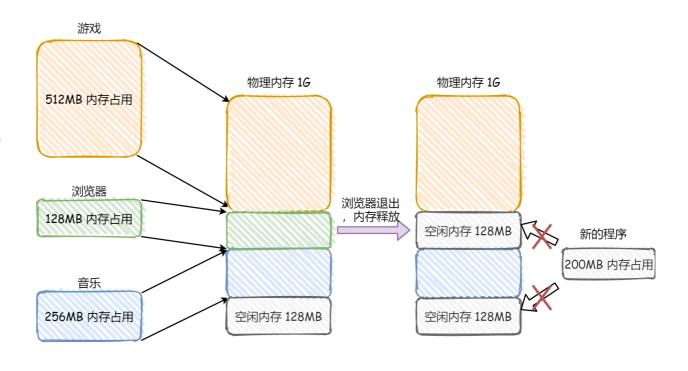






虚拟内存(早期):

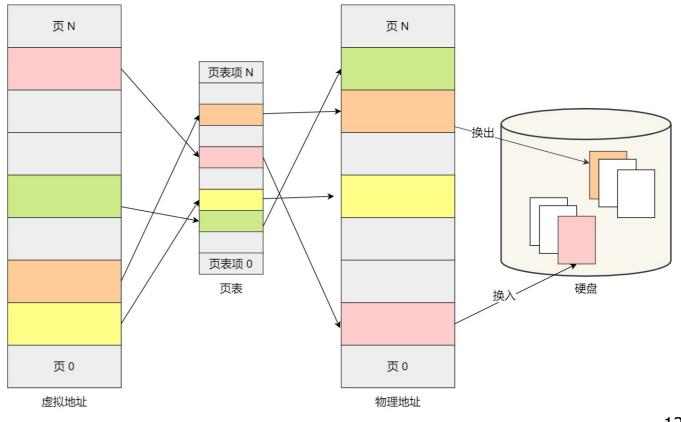
- 内存碎片问题
- Swap 模式,将部分内存中的内容移动到硬盘,再执行的内容移动到硬盘,再执行新的程序,待需要再使用到移动的内容时,再将其重新移动到内存中
- Swap 模式需要和硬盘交换 数据,会拖慢程序运行



5.2.3 程序读写内存的方式

虚拟内存:

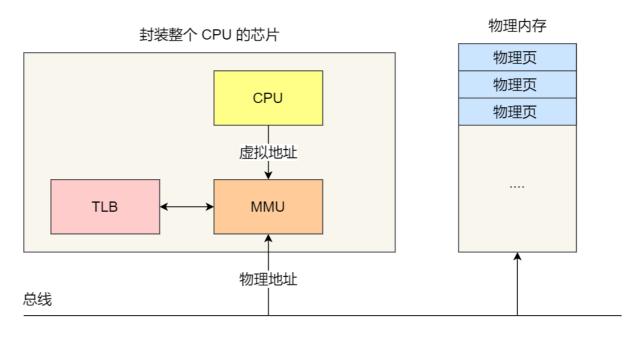
- 为了解决内存碎片无法利用的问题,同时减少Swap 拖慢运行,将内存分为更小的页 (Page) 单元,一般一个页大小为 4K或更小
- 进行地址映射将连续的虚 拟地址映射到物理地址中 的各个页中





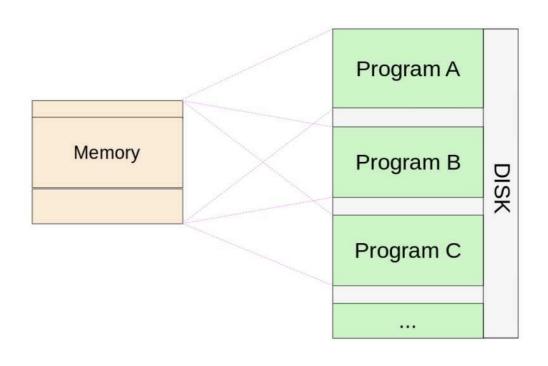
MMU(Memory Management Unit),即内存管理单元,是现代CPU 架构中不可或缺的一部分,MMU 主要包含以下几个功能:

- 虚实地址翻译
- 访问权限控制
- 引申的物理内存管理



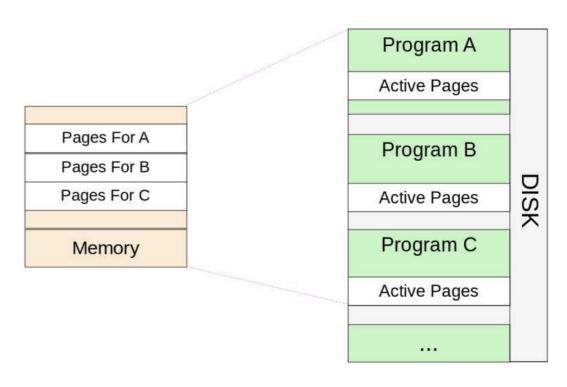


Swap 模式:早期计算机在执行 程序时,将程序从磁盘加载到内 存执行中执行,在多用户系统 中,当新的用户程序被执行前, 需要先将当前用户的程序从内存 swap到磁盘,然后从磁盘加载 新的程序执行, 当前用户退出 后,再将前一用户程序从磁盘中 加载到内存继续执行,每次用户 切换伴随程序的 swap ,消耗较 大。



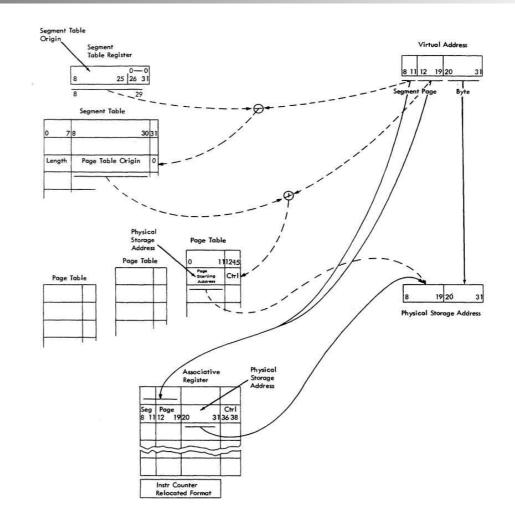


■ Page 模式:将内存划分为固定大小的 Page,一般为 4K 或者更小,这样用户程序按需以 Page的方式加载到内存,不需要将整个程序加载到内存,这样内存可同时容纳更多程序,而无需按照用户切换进行 swap,提升了内存利用率和加载时间。



5.2.2 MMU 的由来

动态地址转换 (DAT - Dynamic Address Translation): 在
 Page 模式基础上,为用户程序分配虚地址 (VA),通过 DAT 转换为物理地址 (PA) 进行访问。

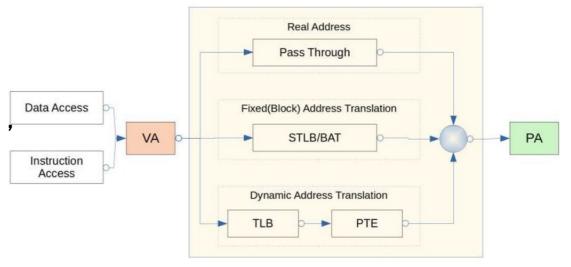


5.2.2 MMU 的由来

- 现代 MMU:可进行实地址模式、块地址转换模式和页地址转换模式三种模式的地址转换。
 - 实地址模式: CPU 状态位中 MMU 使能位清零, MMU 处于关闭状态,此时 CPU 操作的地址不经过转换 (VA=PA),直接作为物理地址进行访问。
 - ▶ 块地址转换模式:或者成为固定的地址转换或静态配置的地址转换表,这种模式支持配置一些固

定的内存地址映射,这种配置没有页 表查找过程转换速度快,但是缺乏灵 活性,一次配置永久使用。

<u>页地址转换模式:</u>将虚拟地址一部分用于索引分段,一部分用于索引页表最终得到物理地址的页起始地址,再加上最后 12 位的页偏移量得到真正的物理地址。

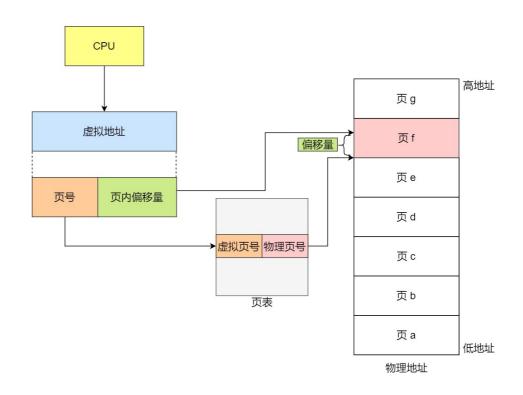


- 相较于 DAT 模式 , MMU :
 - 増加了 PTE 表的缓存 TLB
 - 支持更大的物理地址 (36bit 以上) 或逻辑地址支持多种 PTE 查找方式,如硬件查找和软件查找

5.2.3 MMU 地址转换

地址翻译:将虚拟地址 (VA) 转换为物理地址 (PA)

- 虚拟地址 (VA) 组成:
 - 虚拟页序号 VPN (virtual paging number),用于索引页表 (Page Table)得到页表条目 (Page Table Entry)
 - 偏移量 (Offset)
- 真实地址 (PA) 组成 = 页表条目 (Page Table Entry) + 偏移量 (Offset) ,即为 PTE::Offset



5.2.3 MMU 地址转换

在 32 位的环境下,虚拟地址空间共有 4GB ,假设一个页的大小是 4KB(2^12) ,那 么就需要大约 100 万 (2^20) 个页,每个页表项需要 4 个字节大小来存储,那么整个 4GB 空间的映射就需要有 4MB 的内存来存储页表,如果有 100 个程序,则在页表的开销将达到 400M ,如果在 64 位系统中将会更大。

■ 为解决这一问题,提出了多级页表



多级页表占用的空间为什么没有更大? (以二级页表为例)

- 局部性原理
- 如果 4GB 的虚拟地址全部都映射到了物理内存上的话,二级分页占用空间确实是 更大了,但是,我们往往不会为一个进程分配那么多内存
- 对于大多数程序来说,其使用到的空间远未达到 4GB ,大部分二级页表无需分配
- 对于已分配的页表项,如果存在最近一定时间未访问的页表,在物理内存紧张的情况下,操作系统会将页面换出到硬盘。
- 例如,假设只有 20% 的一级页表项被用到了,那么页表占用的内存空间就只有
 4KB(一级页表)20%*4MB(二级页表)=0.804MB,比单级页表占用(4M)更小

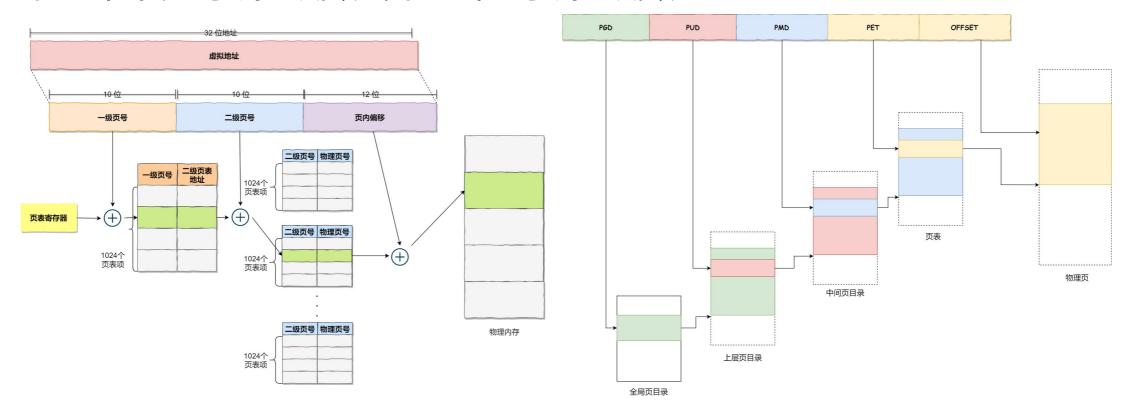


为何单级页表不能部分分配?

- 页表一定要覆盖全部虚拟地址空间
- 以4G虚拟地址空间为例,不分级的页表就需要有100多万个页表项来映射,而二级分页则只需要1024个页表项(此时一级页表覆盖到了全部虚拟地址空间,二级页表在需要时创建)

5.2.3 MMU 地址转换

在32位系统中多为2级页表,在64位中多为4级页表

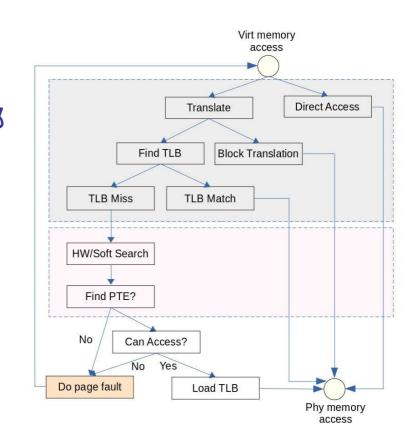


5.2.3 MMU 地址转换

多级页表意味着更多次的转换,如何解决效率问题?

- 局部性原理
- 在一段时间内,整个程序的执行仅限于程序中的某一部分,执行所访问的存储空间也局限于某个内存区域
- 转译后备缓冲器 TLB(Translation lookaside Buffer),存放程序最常访问的页表项的 Cache
- 在访问虚拟地址时,先查询 TLB 中是否存在,不存在 则进行常规页表查询
- Do Page Fault , 分为几种情况:

- 新申请内存第一次读写,触发物理内存分配
- 进程 fork 后子进程写内存触发 Copy-On-Write。





ROM:

- 是 Read-Only Memory 的缩写,可译为只读存储器。 ROM 可以永久存储数据,并且和 RAM 一样,是计算机中主要的存储器。
- 常见的 ROM 如游戏卡带、电脑固态硬盘等



ROM 分类:

- 掩模式只读存储器 (MROM):内部数据在制造时嵌入,后期不允许修改或删除
- 可编程只读存储器 (PROM):可编程 ROM,但编程后无法修改
- 可擦除可编程只读存储器 (EPROM):利用特殊设备 (例如 PROM 编程器)可实现多次编程,同时利用特定频率的紫外线可在 40 分钟左右删除 PROM 存储的数据
- 带电可擦可编程只读存储器 (EEPROM): 支持多次编程和删除 (最多可 10000 次),但无需借助紫外线就可以删除内部存储的数据
- 快闪存储器 (FLASH ROM , 简称闪存): EEPROM 的高级版本,它的优势在于,用户可以在特定时间内一次性删除或写入 512 个字节的数据。而
 EEPROM 一次性只能写入或删除 1 个字节的数据。闪存的读写效率很高,并且可以承受高温和高压,所以非常耐用



谢谢大家!